様式 C-19

科学研究費補助金研究成果報告書

平成22年5月27日現在

研究種目:基盤研究(B)
研究期間:2007~2009
課題番号:19360158
研究課題名(和文) 超高分解能ミリ波マイクロスコピーの開発
研究課題名(英文) Development of Ultra-High Resolution Millimeter-Wave Microscopy
研究代表者
莅戸 立夫(NOZOKIDO TATSUO)
富山大学・大学院理工学研究部(工学)・准教授
研究者番号:00261149

研究成果の概要(和文):超高分解能画像計測技術の開発を、電波の高周波帯に位置するミリ波帯で実施した。本研究では、従来ミリ波帯で達成されている空間分解能を格段に改善し得る高感度画像計測用センサー(プローブ)を開発することにより、観測波長の1000分の1以下、ミクロンオーダーでの画像取得を初めて可能とした。本研究の成果はミリ波帯における超高分解能画像計測技術の実用化に寄与するところが大であり、未だ十分でないミリ波帯電磁波の有効利用を促進し得るものと考えられる。

研究成果の概要(英文): In this research project, ultra-high resolution imaging techniques have been developed by scanning near-field microscopy in the millimeter waveband located in the high-frequency region of the radio-frequency spectrum. We have designed and fabricated novel high-sensitivity near-field probes which can attain much better spatial resolution than that obtained with conventional near-field probes used in the millimeter-wave region. The record image resolution of the order of few microns has been experimentally demonstrated. The results obtained during this research project contribute greatly to the development of high-resolution imaging technology in the millimeter-wave region and could therefore advance utilization of the millimeter wave whose potential has not been fully exploited.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2007年度	8,600,000	2, 580, 000	11, 180, 000
2008年度	2,800,000	840,000	3, 640, 000
2009年度	2, 300, 000	690,000	2, 990, 000
年度			
年度			
総計	13, 700, 000	4, 110, 000	17, 810, 000

交付決定額

研究分野:工学

科研費の分科・細目:電気電子工学・ 電子デバイス・電子機器 キーワード:ミリ波、マイクロスコピー、走査型近接場顕微鏡技術、プローブ、高分解能、高 感度、画像化 1. 研究開始当初の背景

通常の光学系と伝搬波を用いる画像化シ ステムでは、分解能は用いる波の波長程度に 制限されるが、走査型近接場顕微鏡ではこの 限界以下の分解能、すなわち波長よりも十分 小さい分解能で物体を観察し画像化するこ とが可能である。近年、光領域における走査 型近接場顕微鏡技術の開発は飛躍的に進歩 しており、既に実用の域に達していると考え られる。走査型近接場顕微鏡技術は当初 10 GHz のマイクロ波を用いて実験的検証が行わ れたものであり、電波領域においても実現可 能である。マイクロ波からテラヘルツ波に至 る高周波帯の電波領域で動作するシステム が実用化されれば、光領域のシステムと同様 に様々な分野への応用が展開されると期待 され、現在、世界各国で研究開発が実施され ている。しかしながら、本研究開発は光領域 と比較して遅れをとっているのが現状であ った。

マイクロ波帯では画像計測用プローブ(センサー)として同軸線路型プローブ、テラヘルツ波領域では散乱型プローブによってナノスケールの分解能が達成されていた。しかしながら、マイクロ波とテラヘルツ波の中間に位置するミリ波帯では分解能は100 µm 程度にとどまっており、本領域における高分解能画像計測技術の開発が望まれていた。

2. 研究の目的

本研究では、この"ミリ波ギャップ"を埋 めることを目指し、従来達成されている空間 分解能を格段に改善し得る超高分解能プロ ーブを開発して画像取得を実施すること、す なわち、超高分解能ミリ波マイクロスコピー (超高分解能ミリ波帯走査型近接場顕微鏡 技術)を開発することを最大の目的として研 究開発を実施した。

3. 研究の方法

(1)高分解能テーパー型スリットプローブの 開発

研究代表者等が提案し開発を実施してき た、金属導波管を用いたテーパー型スリット プローブの高分解能化を検討した。本プロー ブは他のプローブと比較して、極めて高感度 な信号検出が可能であるという特長を有し ている。従来、電気鋳造及び機械工作でプロ ーブを製作していたため、達成可能な分解能 化は100 µm 程度であった。更なる高分解能 化を目指して提案した新たなプローブ構造 を図1に示す。従来のテーパー型スリットプ ローブの先端に、微細加工に有効な MEMS 技 術(半導体プロセス技術)で製作した、金メ ッキを施したシリコン製チップを装着する ものである。シリコン製チップ先端のスリッ ト状開口の高さ h₂程度の二次元空間分解能



図1 MEMS技術で製作したシリコンチップ を装着する新型スリットプローブ (a) プロ ーブ全体図、 (b) シリコンチップの構造

を達成可能である。三次元電磁界シミュレー タ(Ansoft HFSS)により、ミリ波帯 60 GHz で チップ寸法の詳細設計を行った。MEMS 技術を 用いてチップを製作し、テーパー型スリット プローブの先端に実装、プローブの特性評価 及び画像取得実験を実施した。

(2)ナイフブレードを用いた散乱型マイクロ スコピーの開発

高分解能化のための第二の方法として、図 2に示す、ナイフブレードを用いた散乱型プ ローブを提案した。ナイフブレードを用いる ことにより、従来の金属針を用いたプローブ と比較して、画像化のための検出信号である 散乱波の強度を格段に大きくすることが可 能と考えられる。ナイフブレードを用いた場 合の二次元画像再構成原理の実験的検証に 重点をおき、60 GHzでミリ波光学系(ミリ波 照射及び検出)の設計・製作、画像取得実験 を行った。なお、(1)も含めて、以上の研究 開発では、プローブの特性評価、画像取得実 験の際、ミリ波帯の高感度特性評価装置であ



図3 スリット型プローブを用いたミリ波帯 パッシブマイクロスコピーの実験システム

る、ベクトル・ネットワーク・アナライザー (VNA)を使用した。(下記アクティブ方式に 相当する)

(3) パッシブマイクロスコピーの開発

超高感度プローブであるスリット型プロ ーブの特長を活かして、新たな顕微観察技術 (マイクロスコピー) であるミリ波帯パッシ ブ(受動型)マイクロスコピーを提案し、本 方法の実験的検証を試みた。従来の走査型近 接場顕微鏡技術では、発振器(光源)からの コヒーレントな波を物体に照射して画像化 を行うアクティブ方式を用いている。本ミリ 波帯パッシブマイクロスコピーは、物体から 自然放出されている熱雑音信号の内のミリ 波成分を受信して、回折限界以下の分解能で 画像化を行うという、完全無侵襲計測を可能 とする全く新たな画像計測技術である。図3 に、パッシブマイクロスコピーの実験システ ムを示す。プローブで検出された微弱な熱雑 音ミリ波信号を受信するために、挿入図で示 す構成のミリ波 Ka帯(26.5-40.0 GHz)で動 作する広帯域低雑音受信器を開発した。プロ



図 4 シリコンチップの製作プロセス (a) と完成したチップの写真 (b)

ーブと無反射終端を交互にスイッチで切り 替え、ダイオード検出器からの出力電圧をロ ックインアンプで計測する、Dicke型の構成 となっている。ミリ波帯熱雑音信号を検出す るための受信システムの特性評価、画像取得 実験を実施した。

4. 研究成果

(1)高分解能テーパー型スリットプローブの 開発

HFSS によるシリコンチップ設計の際、チッ プ底面の導波管幅 Wと高さHを調整すること により、プローブの透過効率すなわち測定感 度を格段に改善できることを見いだした。幅 Wと高さ Hを適切に選択すると、チップ先端 部の開口高さ h_s を μ m、サブ μ m オーダーにし ても、透過効率 100 %を実現可能という高分 解能化における重要な設計指針を得ること ができた。

図4に、シリコンチップ製作のために開発 した異方性ウエットエッチングを用いた製 作プロセス(a)と製作したシリコンチップの 写真(b)を示す。幅4.5 mm、高さ25 µm とい う高い寸法比を有する直線性良好なスリッ ト状開口の形成に成功した。

製作した2種類のシリコンチップ(*h*_sはと もに25 µm)をそれぞれテーパー型スリット プローブの先端に装着し、60 GHz でプローブ の基礎特性評価を実施した結果を図5に示す。



図5 シリコンチップを装着したスリット 型プローブの基礎特性(測定対象の誘電率に 対するプローブ反射係数の変化)



図6 取得画像 (a) 測定対象の構造、 (b) 通常のスリット型プローブ (*h* = 90 µm) で 得られた画像、(c) シリコンチップ (*W*=4.87 mm, *H* = 360 µm) を装着したスリット型プロ ーブで得られた画像、 (d) シリコンチップ (*W* = 1.90 mm, *H* = 330 µm) を装着したス リット型プローブで得られた画像 (画像サイ ズ:1 mm×1 mm)

本図は、測定対象の誘電率を変化させた場合 のプローブ反射係数 S_{11} の強度変化を示して いる。図上部に、測定対象とした誘電体基板 の材料名を記載している。通常のスリット型 プローブ ($h = 90 \mu m$) では誘電率が増加す るに従って 0.95 から 0.9 程度しか変化しな かった反射係数が、シリコンチップを装着す



図7 ナイフブレードを用いたミリ波帯散 乱型マイクロスコピーの実験システム

ることによって開口高さ(h_s)が小さくなっているにもかかわらず、大きく改善されていることがわかる。更に本結果より、HFSSによる理論計算結果と実験値との良い一致も確認できた。

図6は、通常のスリット型プローブ、2種 類のシリコンチップをそれぞれ装着したス リット型プローブを用いて、60 GHzで取得し たミリ波画像である。測定対象は、図6(a) に示す石英基板に蒸着したアルミニウム (A1) パッチである。直線スキャンと回転ス キャンを組み合わせたスキャン方法でデー タを取得し、本データを本研究で開発した画 像再構成プログラムで処理することにより、 スリット開口高さとほぼ同程度の二次元空 間分解能を有する画像が得られている。(次 に記載する(2)、(3)においても同様のスキ ャン方法、画像再構成プログラムを使用して いる)シリコンチップを装着することにより、 画像コントラストが約20dBと大幅に改善さ れることが確認できた。

(2)ナイフブレードを用いた散乱型マイクロ スコピーの開発

ナイフブレードをプローブとして用いた 場合の画像再構成原理の実験的検証を行う ために、先ず、市販のカッターナイフに金メ ッキを施してプローブとして使用した。実験 システムを図7に示す。挿入図は、使用した プローブ(ナイフブレード)の構造を示して いる。プローブ先端部の曲率半径 R は 3 µm である。VNA からのミリ波(60 GHz)を円形 ホーンアンテナでプローブ先端に照射し、散 乱波をポリエチレン製レンズで集光、方形ホ ーンアンテナで受信した後、VNA で計測して 画像化のためのデータを取得した。





Upper View



Front View



図8は、図6(a)を対象として得られた再 構成画像(強度画像、位相画像)である。図 6と比較して、更に優れた分解能の画像が得 られていることがわかる。画像解析を実施し、 分解能がプローブ先端部の曲率半径とほぼ 等しい値となっていることを確認した。本分 解能は観測波長 5 mm の約 1/1000 に相当し、 ミリ波帯では世界最高の値である。

更なる高分解能化を図るために、シリコン 基板を材料として、シリコンの異方性エッチ ングを利用したナイフブレードの製作に関 する検討も実施した。図9に、製作したナイ フブレードの SEM 画像を示す。先端部曲率半 径 0.1 µm の、直線性良好なナイフブレード を製作することに成功したものの、研究期間 内では特性評価、画像取得実験を実施するに は至らなかった。



図10 電波吸収材料 (RAM) の温度に対す るロックインアンプ出力電圧の変化



図11 パッシブマイクロスコピーの取得 画像(a) 測定対象の構造、(b) 再構成画像 (画像サイズ: 7.5 mm×7.5 mm)

(3) パッシブマイクロスコピーの開発

プローブとしては、Ka 帯の金属導波管を用 いたテーパー型スリットプローブを用いた。 プローブ先端部のスリット開口の高さは 150 um である。図10に、プローブも含めたミリ 波帯熱雑音信号受信システムの特性評価の 結果を示す。挿入図のように、プローブを測 定対象である電波吸収材料 (Radar Absorbing Material: RAM) に密着させ、測定対象の温 度を変化させた場合のロックインアンプの 出力電圧を計測した。出力電圧は測定対象の 温度に比例していることから、スリット型プ ローブは測定対象から放出されている熱雑 音信号を受信可能であることが確認できた。 本結果より、Y ファクター法を用いて、本受 信システムのシステム雑音温度として1650K という値が得られた。本雑音温度は、ロック インアンプの時定数が1秒の場合、28 mKの 温度分解能に相当するものである。

図11は図3で示した実験システムで得ら れたミリ波画像である。測定対象は、図11 (a)に構造を示す、中心に直径 1 mm の孔を有



図12 温度差に対応する差分画像(a)と 画像強度の変化(b)

するドーナツ型の電波吸収材料 (RAM) である。 電波吸収材料の温度を 295 K から 316 K まで 変化させて測定したミリ波画像を図11(b) に示す。本図では各温度に対応する画像の差 は明らかでない。温度差の影響を現す差分画 像を図12(a)に示す。図のように、温度差 が大きくなるほど画像強度が増加している ことがわかる。更に、測定対象中心部の、観 測波長の 1/10 程度の大きさを有する孔が明 確に画像化されている。図12(b)は、図1 2(a)の画像より、画像上3点の画像強度を 温度差に対してプロットした結果である。本 図より、画像強度も温度差に比例して変化す ることが確認できた。

以上の実験結果は、物体から自然放出され ている熱雑音信号の内のミリ波成分を受信 して、回折限界以下の分解能での画像化に成 功したことを示している。本結果は、熱雑音 信号のエバネッセント波成分をも画像化し た最初の実験結果であると認識している。

以上の成果は、ミリ波帯における超高分解 能画像計測技術の実用化に寄与するところ が大であり、未だ十分でないミリ波帯電磁波 の有効利用を促進し得るものと考えている。 本研究の開始時は、ミリ波利用の新たな可 能性を探索するために、生体組織を対象とし た画像計測を試みることも目的としていた が、有意な画像を得るには至らなかった。今 後は、本研究で対象としたミリ波帯画像計測 システムの更なる高分解能化、高感度化、高 機能化を推進するとともに、再度生体組織も 含めた新たな対象を選択し、画像取得実験を

実施していく計画である。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計4件)

① <u>T. Nozokido</u>, N. Miyasaka, T. Murai, J. Bae, Near-Field Slit Probe Incorporating a Micromachined Silicon Chip for Millimeter-Wave Microscopy, to appear in the Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves、査読有、2010

② <u>T. Nozokido</u>, S. Maede, N. Miyasaka、 H. Okada 、 T. Nose 、 and T. Murai 、 A Millimeter-Wave Quasi-Optical Grid Phase Shifter Using Liquid Crystal 、 IEICE Electronics Letters、査読有、Vol. 7、pp. 67-72、2010

 ③ <u>T. Nozokido</u>、M. Noto、and T. Murai、 Passive Millimeter-Wave Microscopy、IEEE Microwave and Wireless Components Letters、 査読有、Vol. 19、pp. 638-640、2009
 ④能登政光、<u>莅戸立夫</u>、村井忠邦、ミリ波帯 パッシブマイクロスコピー、電子情報通信学 会技術報告、査読無、MW2008-147、pp. 7-12、 2008

〔学会発表〕(計1件)

 <u>
 莅戸立夫</u>、ミリ波帯パッシブマイクロス コピー、電子情報通信学会マイクロ波研究会、
 2008 年 12 月 12 日、富山大学

6. 研究組織

(1)研究代表者 莅戸 立夫 (NOZOKIDO TATSUO) 富山大学・大学院理工学研究部(工学)・ 准教授 研究者番号:00261149
(2)研究分担者 工藤 博幸 (KUDO HIROYUKI) 筑波大学・大学院システム情報工学研究科・ 教授 研究者番号:60221933 佐々木 和男 (SASAKI KAZUO) 富山大学・大学院理工学研究部(工学)・ 教授 研究者番号:60042826

(3)連携研究者該当なし